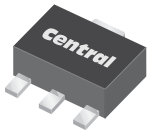
CXT3019

SURFACE MOUNT
NPN SILICON TRANSISTOR



SOT-89 CASE

Central Semiconductor Corp.

www.centralsemi.com

DESCRIPTION:
The CENTRAL SEMICONDUCTOR CXT3019 type is an NPN silicon transistor manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in a surface mount package, designed for high current general purpose amplifier applications.

MARKING: FULL PART NUMBER

MAXIMUM RATINGS: (T_A=25°C)	**SYMBOL**		**UNITS**
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	140	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	80	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	7.0	V
Continuous Collector Current	I_C	1.0	A
Peak Collector Current	I_{CM}	1.5	A
Power Dissipation	P_D	1.2	W
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +175	°C
Thermal Resistance	Θ_{JA}	125	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: (T_A=25°C unless otherwise noted)

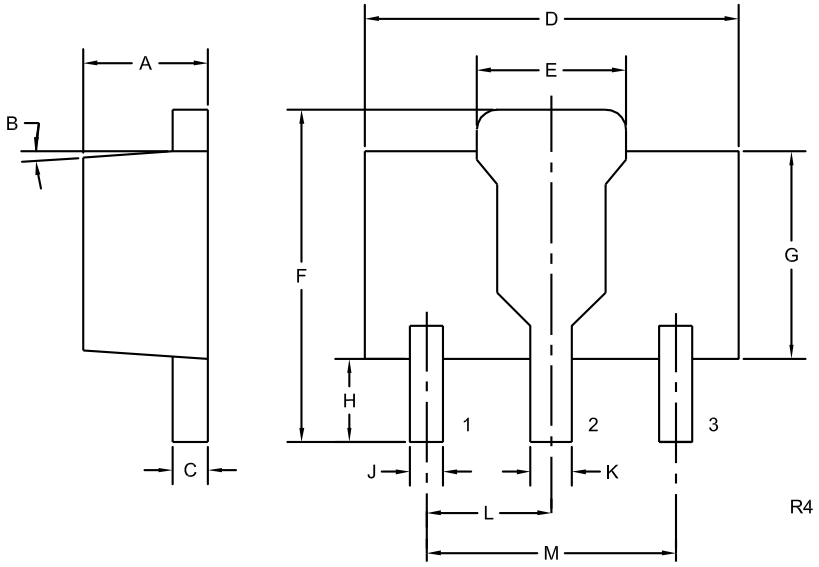
SYMBOL	**TEST CONDITIONS**	**MIN**	**MAX**	**UNITS**
I_{CBO}	V_{CB}=90V		10	nA
I_{EBO}	V_{EB}=5.0V		10	nA
BV_{CBO}	I_C=100μA	140		V
BV_{CEO}	I_C=30mA	80		V
BV_{EBO}	I_E=100μA	7.0		V
$V_{CE(SAT)}$	I_C=150mA, I_B=15mA		0.2	V
$V_{CE(SAT)}$	I_C=500mA, I_B=50mA		0.5	V
$V_{BE(SAT)}$	I_C=150mA, I_B=15mA		1.1	V
h_{FE}	V_{CE}=10V, I_C=0.1mA	50		
h_{FE}	V_{CE}=10V, I_C=10mA	90		
h_{FE}	V_{CE}=10V, I_C=150mA	100	300	
h_{FE}	V_{CE}=10V, I_C=500mA	50		
h_{FE}	V_{CE}=10V, I_C=1.0A	15		
f_T	V_{CE}=10V, I_C=50mA, f=1.0MHz	100		MHz
C_{ob}	V_{CB}=10V, I_E=0, f=1.0MHz		12	pF
C_{ib}	V_{EB}=0.5V, I_C=0, f=1.0MHz		60	pF
NF	V_{CE}=10V, I_C=100μA, R_S=1.0kΩ, f=1.0kHz		4.0	dB

R7 (23-February 2010)

CXT3019

SURFACE MOUNT
NPN SILICON TRANSISTOR

SOT-89 CASE - MECHANICAL OUTLINE



(Bottom View)

LEAD CODE:
1) Emitter
2) Collector
3) Base

MARKING:
FULL PART NUMBER

DIMENSIONS				
	INCHES		MILLIMETERS	
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.055	0.067	1.40	1.70
B	4°		4°	
C	0.014	0.018	0.35	0.46
D	0.173	0.185	4.40	4.70
E	0.064	0.074	1.62	1.87
F	0.146	0.177	3.70	4.50
G	0.090	0.106	2.29	2.70
H	0.028	0.051	0.70	1.30
J	0.014	0.019	0.36	0.48
K	0.017	0.023	0.44	0.58
L	0.059		1.50	
M	0.118		3.00	

SOT-89 (REV: R4)

R7 (23-February 2010)

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9